
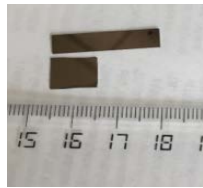
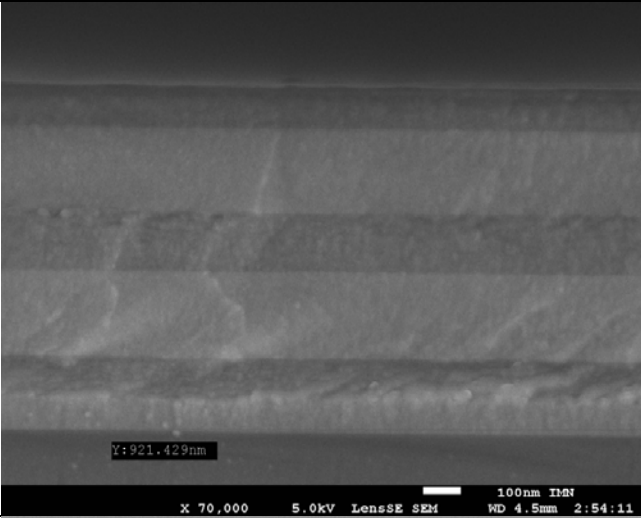



- description de chaque échantillon : dimensions (largeur, longueur et épaisseur), structure (substrat et épaisseur des couches), matériaux isolants ou non, ...

Sample	Substrate	Layer thickness	Layer structure	Insulation	Intrinsic stress	dimension
IB303	Si(100)	920 nm	Si(substrate)/HfB <sub>2</sub> /HfBN/HfB <sub>2</sub> /HfBN	No	-4GPa	Thickness (substrate) : 250um ; 
IB230	Si(100)	167 nm	Si(substrate)/HfBN	No	-1.9GPa	Thickness (substrate) : 250um ; 

- localisation et orientation des coupes (images optique et/ou MEB si nécessaire) : Maximum observation possible SEM ...

Sample	SEM cross section
IB303	
IB230	

- profondeur et longueur de la lame (jusqu'à quelle profondeur vous souhaitez observer la lame et sur quelle longueur) :

	profondeur et longueur de la lame
IB303	The thickness of the sample (at least 500nm)
IB230	The total thickness (167nm) of the sample

- type d'analyse TEM (EDX, haute résolution, ...) et ce que vous souhaitez observer au TEM :

	souhaitez observer au TEM	type d'analyse TEM
IB303	Cross section structure; phase composition; interface between the substrate and thin film; interface between different layers	EDX, SAED, HRTEM, bright-field (We have the TEM equipment in IMN)
IB230	Cross section structure; phase composition; interface between the substrate and thin film;	

- possibilité de déposer une couche de protection sur toute la surface de l'échantillon (carbone) = couche de protection et conductrice (pour matériaux isolant)

No

- précaution de stockage (lumière, atmosphère contrôlé (azote)...) )

No